

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11)



EP 0 762 496 A2

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

12.03.1997 Patentblatt 1997/11

(51) Int Cl. 6: H01L 23/49, H01L 23/48,  
H01L 25/07

(21) Anmeldenummer: 96810501.5

(22) Anmeldetag: 26.07.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:

DE FR GB IT

- Keser, Helmut  
5408 Ennetbaden (CH)
- Steinruck, Ferdinand  
6295 Mosen (CH)
- Zehringen, Raymond, Dr.  
5444 Künten (CH)

(30) Priorität: 17.08.1995 DE 19530264

(71) Anmelder: ABB RESEARCH LTD.  
CH-8050 Zürich 11 (CH)

(72) Erfinder:

- Faller, Kurt  
5200 Brugg (CH)
- Frey, Toni, Dr.  
La Jolla, CA 92037 (US)

(74) Vertreter: Weibel, Beat et al  
c/o Asea Brown Boveri AG,  
Intellectual Property Department (TEI),  
Bldg. 699/1st Floor,  
P.O. Box  
5401 Baden (CH)

### (54) Leistungshalbleitermodul

(57) Es wird ein Leistungshalbleitermodul angegeben, bei welchem mindestens ein Halbleiterchip, welcher auf einer Grundplatte angebracht ist von je einem Kontaktstempel kontaktiert wird. Die Lage der Kontakt-

stempel ist entsprechend einem Abstand von den Halbleiterchips zu einem die Kontaktstempel aufnehmenden Hauptanschluss individuell einstellbar. Die Kontaktstempel werden entweder mittels einer Feder mit Druck beaufschlagt oder mittels einer Lotschicht fixiert.

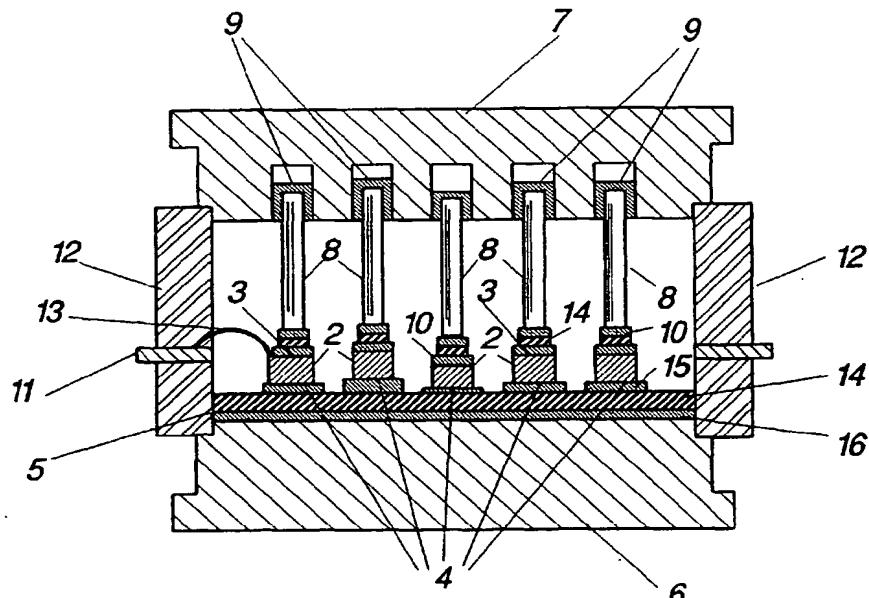


Fig. 1

## Beschreibung

### Technisches Gebiet

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Leistungselektronik. Sie geht aus von einem Leistungshalbleitermodul nach dem Oberbegriff des ersten Anspruchs.

### Stand der Technik

Ein solches Leistungshalbleitermodul wird schon im US Patent mit der Nummer 5,221,851 beschrieben. Es handelt sich dabei um sogenanntes Druckkontakt-Halbleitermodul, bei welchem mehrere Halbleiterchips mit ihrer ersten Haupteletrode auf einer Grundplatte aufgebracht sind. Die zweiten Haupteletroden der Chips werden von einer Mehrzahl von Kontaktstempeln kontaktiert. Die Grundplatte ist mit einem ersten Hauptanschluss und die Kontaktstempel sind mit einem zweiten Hauptanschluss verbunden. Die Hauptanschlüsse können scheibenförmig ausgebildet sein und mittels Flanschen zusammengehalten werden. Der Druckkontakt ist also in Form eines Kupferstempels ausgebildet, welcher auf die einzelnen Chips drückt.

Problematisch bei dieser Anordnung sind jedoch die Anforderung an die Planparallelität der Chipoberflächen bzw. der Kupferstempel. Die für einen Druckkontakt benötigte Planparallelität beträgt beispielsweise bei einer kreisrunden Scheibe mit einem Durchmesser von 7 cm nur wenige Mikrometer. Diese Anforderung bei einer Anordnung mit einer Mehrzahl von Chips einzuhalten ist sehr schwierig, da die einzelnen Chips mit konventioneller Löttechnik praktisch kaum auf einer gemeinsamen Höhe geschweigt den planparallel gelötet werden können.

### Darstellung der Erfindung

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, ein Leistungshalbleitermodul anzugeben, bei welchem weniger hohe Anforderungen an die Planparallelität gestellt werden.

Diese Aufgabe wird bei einem Leistungshalbleitermodul der eingangs genannten Art durch die Merkmale des ersten Anspruchs gelöst.

Kern der Erfindung ist es also, dass die Lage des oder jedes Kontaktstempels entsprechend dem Abstand von dem oder jedem Halbleiterchip zum zweiten Hauptanschluss individuell eingestellt werden kann. Da die Lage der Kontaktstempel für jeden Halbleiterchip individuell eingestellt werden kann, spielt die Planparallelität keine derart grosse Rolle mehr.

Die Kontaktstempel sind beweglich gelagert. Zur Einstellung der Position sind dafür ausgebildete Mittel vorgesehen. Diese können beispielsweise eine Lotschicht oder eine Feder mit allfälligen Gleitkontakten umfassen. Die Lotschicht umgibt den Kontaktstempel in

dafür vorgesehenen Bohrungen und dient sowohl der mechanischen Fixierung der Kontaktstempel als auch der elektrischen Kontaktierung. Bei der Variante mit den Federn sind diese in den Bohrungen angeordnet, welche für die Aufnahme der Kontaktstempel vorgesehen sind. Zur Verbesserung des elektrischen Kontaktes können außerdem ein Gleitkontakt, z.B. in Form einer Gleitfeder mit einer Vielzahl von Einzellamellen aus elektrisch gut leitendem Material, entlang der Seitenwände der Bohrungen vorgesehen werden.

Halbleitermodule, bei welchen die Kontaktstempel mittels Lötung fixiert werden, werden am besten so hergestellt, dass zunächst die Halbleiterchips auf die Grundplatte aufgelötet werden. Anschliessend wird die Grundplatte mit den Halbleiterchips in den mit mindestens einer Bohrung und mit mindestens einem Kontaktstempel und dazwischen gefügter Lotschicht bestückten zweiten Hauptanschluss eingesetzt. Die Lage der Grundplatte zum zweiten Hauptanschluss wird nun fixiert, und das Halbleitermodul mit nach oben weisendem zweiten Hauptanschluss in einem Lötofen verlötet. Dabei schmilzt die Lotschicht zwischen dem Kontaktstempel und dem zweiten Hauptanschluss und fixiert die individuelle Position der Kontaktstempel. Diese wurde aufgrund der Schwerkraft vor dem Lötvorgang automatisch eingestellt.

Der Vorteil der Erfindung liegt also darin, dass keine derart hohen Anforderungen an die Planparallelität mehr notwendig sind. Dies erlaubt insbesondere eine kostengünstige Herstellung der Module. Außerdem gewährleistet die Kontaktierung der Chips mittels Kontaktbolzen, seien diese angelötet oder mittels Federn mit Druck beaufschlagt, für einen permanenten und individuellen Druck auf jeden einzelnen Chip. Insbesondere im Falle, dass das Modul oder Teile davon im Falle eines Fehlers aufschmelzen, wird dadurch ein permanenter niederohmige Übergangswiderstand zwischen den Gehäusekontakte und dem Chip erreicht. Beim Stand der Technik schmelzen die Bonddrähte durch. Dies kann zu einer vollständigen Zerstörung des Bauelements führen. Somit bietet die erfindungsgemäße Art der Kontaktierung zusätzlich den Vorteil, dass bei Ausfall eines der intern parallelgeschalteten Chips der ganze Nominal- aber auch der Kurzschlussstrom niederohmig über den defekten Chip geleitet werden kann.

Weitere Ausführungsbeispiele ergeben sich aus den entsprechenden abhängigen Ansprüchen.

### Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit den Zeichnungen näher erläutert.

Es zeigen:

**Fig. 1** Einen Schnitt durch ein erfindungsgemässes Leistungshalbleitermodul nach einer ersten Ausführungsform; und

**Fig. 2** Einen Schnitt durch ein erfindungsgemässes Leistungshalbleitermodul nach einer zweiten Ausführungsform.

Die in den Zeichnungen verwendeten Bezugszeichen und deren Bedeutung sind in der Bezeichnungsliste zusammengefasst aufgelistet. Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

### Wege zur Ausführung der Erfindung

Figur 1 zeigt ein erstes Beispiel, wie die Erfindung realisiert werden kann. Mit 1 ist ein Leistungshalbleitermodul bezeichnet, welches einen ersten und einen zweiten Hauptanschluss 6, 7 aufweist. Die Hauptanschlüsse 6,7 können aus einem massiven Kupferblock bestehen. Auf den ersten Hauptanschluss 6 ist eine Grundplatte 5 aufgebracht. Dies kann beispielsweise eine Molybdänplatte 14, eine Keramikplatte oder ein Platte aus anderen geeigneten Materialien sein, welche mit einer Lotschicht 16 auf dem ersten Hauptanschluss 6 befestigt ist. Der Querschnitt der Grundplatte ist für die Erfindung nicht von Bedeutung. Er kann rund oder eckig sein. Auf die Grundplatte 5 sind mehrere, allgemeiner mindestens ein Halbleiterchip 2 aufgelötet. Vorzugsweise handelt es sich bei den Halbleiterchips um IGBT-Chips oder um Diodenchips oder um eine Kombination dieser Arten von Chips. Grundsätzlich weisen die Chips 2 jedoch mindestens zwei Haupteletroden 3 und 4 auf, welche von den entsprechenden Hauptanschlüssen 6 und 7 kontaktiert werden. Im Falle von IGBT-Chips ist noch eine dritte Elektrode, eine Steuerelektrode vorgesehen, welche über einen Anschlussdraht 13 mit einem Steueranschluss 1 verbunden ist. Der Anschlussdraht 13 wird z.B. auf die Steuerelektrode des Chips 2 gebunden. Die eine Haupteletrode 4 wird durch die Unterseite des Chips 2 gebildet und steht in direkter Verbindung mit der Grundplatte 5.

Die andere Haupteletrode 3 der Halbleiterchips 2 wird von einer der Anzahl Chips entsprechenden Anzahl von Kontaktstempeln 8 kontaktiert. Wie eingangs bereits erläutert wurde, besteht ein Problem bei den Leistungshalbleitermodulen darin, dass es Schwierigkeiten bereitet, die Chips 2 auf dieselbe Höhe anzulöten. Der hohe Grad an Planparallelität ist jedoch für einen problemlosen Druckkontakt notwendig. Um die Problematik deutlich zu machen, sind in Figur 1 die unterschiedlich dicken Lotschichten 15 überzeichnet dargestellt. Auch im Falle von unterschiedlich dicken Chips, z.B. bei einer Kombination von verschiedenen Chiptypen, ergibt sich eine unterschiedliche Höhe der Stapel bestehend aus Lotschichten, allenfalls dazwischen gefügten Molybdänscheiben und Halbleiterchips. Mit der Erfindung gelingt es nun, ein Leistungshalbleitermodul zu bauen, bei welchem diese Unterschied keinen Nachteil mehr darstellen.

Dies wird dadurch erreicht, dass die Kontaktstem-

pel 8 vor der eigentlichen Montage beweglich in ihren Bohrungen des zweiten Hauptanschlusses 7 angeordnet sind. Um die Kontaktstempel nach der Montage fixieren zu können, ist zwischen der Bohrung und dem 5 Kontaktstempel 8 nach dem ersten Ausführungsbeispiel eine Lotschicht 9 vorgesehen. Bei der Montage wird diese Lotschicht in einem Lötofen zum Schmelzen gebracht, so dass die Kontaktstempel fixiert werden. Eine selbsttätige Anpassung der Kontaktstempel-Länge 10 an den individuellen Abstand zwischen dem zweiten Hauptanschluss 7 und den Halbleiterchips 2 erreicht man am einfachsten und vorzugsweise dadurch, dass das Halbleitermodul mit dem zweiten Hauptanschluss 7 nach oben verlötet wird. Die Kontaktstempel 8 fallen 15 durch die Schwerkraft nach unten und kontaktieren die Chips. Zwischen den Chips 2 und den Kontaktstempeln 8 ist eine weitere Lotschicht 10, allenfalls mit dazwischen gefügter Molybdänscheibe vorgesehen. Diese Lotschicht 10 wird im gleichen Arbeitsschritt wie die Lotschicht 9 im Lötofen verlötet. Um die Lage des ersten Hauptanschlusses gegenüber dem zweiten Hauptanschluss zu fixieren, wird die Anordnung mit einer Fixierungsvorrichtung umgeben, welche nach erfolgter Justierung 20 eine präzise ausgerichtete Verbindung der Kontaktstempel 8 auf den Chips 2 während des Lötorganges gewährleistet.

Ein wie oben beschrieben aufgebautes Leistungshalbleitermodul kann beispielsweise in ein von der GTO-Technologie bekanntes Druckkontaktegehäuse 30 eingebaut werden. In diesem Fall ist es von Vorteil, wenn zwischen dem ersten und dem zweiten Hauptanschluss 6 und 7 ein Stützring 12 vorgesehen ist. Dieser entlastet die Lötstellen des Chips und die Kontaktstempel vom Druck. Ein allfällig vorgesehener Steueranschluss 11 wird dann am besten durch den Stützring 12 hindurchgeführt.

Figur 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemässen Leistungshalbleitermoduls. Der Aufbau entspricht im wesentlichen demjenigen 40 nach Figur 1, und entsprechende Teile sind mit denselben Bezugszeichen versehen. Zur Fixierung und Einstellung der Länge der Kontaktstempel 8 sind hier aber nicht Lotschichten 9, sondern eine Kombination von Federn 18 und einem Gleitkontakt 17 vorgesehen. Die Federn sind in Bohrungen des zweiten Hauptanschlusses 7 angeordnet und beaufschlagen die Kontaktstempel 8 mit Druck. Auf diese Art wird die Länge der Kontaktstempel eingestellt. Zur Verbesserung des elektrischen Kontaktes zwischen den Kontaktstempeln 8 und dem zweiten Hauptanschluss 7 können außerdem Gleitkontaktefedern 45 17 vorgesehen werden. Diese sind entlang der Bohrungswände zwischen den Kontaktstempeln und dem Hauptanschluss angeordnet. Die Federgleitkontakte können eine Vielzahl von Einzellamellen aufweisen.

Die mit Federdruck beaufschlagten Kontaktstempel 8 pressen nun auf die Chips 2. Im Gegensatz zum ersten Ausführungsbeispiel, in welchem zur Kontaktie-

rung der Chips 2 eine Kombination von Lotschichten 10 und Mo-Plättchen 14 benötigt wird, reicht hier eine direkte Kontaktierung der Chips 2 mit den Kontaktstempeln 8 aus.

Mit dem erfindungsgemässen Leistungshalbleitermodul ist es auch möglich, verschiedene Typen von Modulen aufzubauen. Wird wie beispielsweise in der eingangs genannte US Patentschrift eine Kombination von IGBT-Chips und Dioden-Chips verwendet, so erhält man ein Schaltermodul, bei welchem die Antiparalleldiode integriert ist. Es jedoch auch denkbar, ganze Halb- oder Viertelbrückenmodule von Umrichtern in einem solchen Leistungshalbleitermodul zu integrieren oder einfach nur eine Hochleistungsdiode zu bauen. Die Erfindung ist im übrigen auch nicht auf IGBTs beschränkt, sondern wird für alle Arten von Leistungshalbleiterchips mit Vorteil eingesetzt. Obwohl die vorstehende Beschreibung von einem kreisrunden Querschnitt des Moduls ausgeht, ist die Erfindung nicht auf solche Querschnitte beschränkt.

Insgesamt ergibt sich mit der Erfindung ein Leistungshalbleitermodul, bei welchem die Anforderungen an die Planparallelität weniger hoch sind als beim Stand der Technik und welches somit einfacher hergestellt und aufgebaut werden kann.

#### Bezeichnungsliste

1	Leistungshalbleitermodul
2	Halbleiterchips
3, 4	Elektroden
5	Grundplatte
6, 7	Hauptanschlüsse
8	Kontaktstempel
9, 10	Lotschicht
11	Steueranschluss
12	Stützring
13	Anschlussdraht
14	Molybdänplatte
15, 16	Lotschicht
17	Gleitkontakt
18	Feder

#### Patentansprüche

1. Leistungshalbleitermodul (1) mit mindestens einem Halbleiterchip (2), welcher oder welche mindestens zwei Elektroden, nämlich eine erste (4) und eine zweite Hauptelektrode (3), aufweisen und welcher oder welche Halbleiterchips (2) mit der ersten Hauptelektrode (4) auf einer Grundplatte (5) angebracht sind, und mit einem ersten und einem zweiten, mit den entsprechenden ersten und zweiten Hauptelektroden (4 bzw. 3) in elektrischer Verbindung stehenden Hauptanschluss (6 bzw. 7), wobei der erste Hauptanschluss (6) mit der Grundplatte (5) elektrisch zusammenwirkt und der zweite

5 Hauptanschluss (7) mindestens einen Kontaktstempel (8) aufweist, welcher oder welche mit der zweiten (3) Hauptelektrode des oder jedes Halbleiterchips (2) elektrisch zusammenwirken, dadurch gekennzeichnet, dass eine Lage des oder jedes Kontaktstempels (8) entsprechend dem Abstand von dem oder jedem Halbleiterchip (2) zum zweiten Hauptanschluss (7) eingestellt werden kann und dass Mittel (9, 10; 17, 18) zur Fixierung der Lage des oder jedes Kontaktstempels (8) vorgesehen sind.

10 2. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Fixierung des oder jedes Kontaktstempels (8) zwei Lotschichten (9, 10) umfassen, welche einerseits zwischen dem oder jedem Halbleiterchip (2) und dem oder jedem Kontaktstempel (8) und andererseits zwischen dem oder jedem Kontaktstempel (8) und einer den oder jeden Kontaktstempel aufnehmenden Bohrung im zweiten Hauptanschluss (7) vorgesehen sind.

15 3. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Fixierung des oder jedes Kontaktstempels (8) für jeden Kontaktstempel eine Feder (18) umfassen, welche in einer den oder jeden Kontaktstempel aufnehmenden Bohrung im zweiten Hauptanschluss (7) angeordnet ist.

20 4. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Kontaktstempeln (8) und den Seitenwänden der Bohrungen elektrisch leitende Gleitfedern vorgesehen sind.

25 5. Verfahren zur Herstellung eines Halbleitermoduls nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass

30 - in einem ersten Schritt der oder jeder Halbleiterchip (2) auf die Grundplatte (5) gelötet wird;

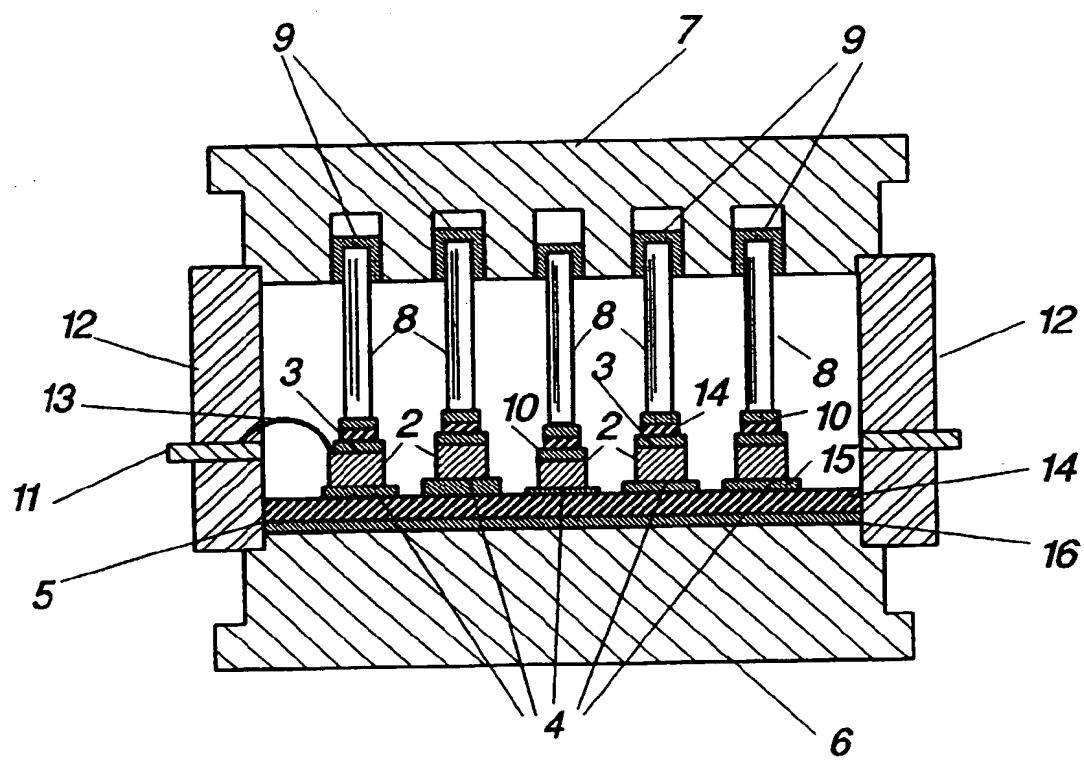
35 - die Grundplatte (5) auf den mit mindestens einer Bohrung, in welche je ein Kontaktstempel (8) eingefügt ist, versehenen zweiten Hauptanschluss (7) aufgesetzt und bezüglich des zweiten Hauptanschlusses (7) fixiert wird, wobei einerseits zwischen dem oder jedem Kontaktstempel (8) und dem oder jedem Halbleiterchip (2) und andererseits in jeder Bohrung zwischen dem oder jedem Kontaktstempel (8) und dem zweiten Hauptanschluss (7) je eine Lotschicht (10 bzw. 9) eingelegt wird;

40 - das Halbleitermodul anschliessend mit dem zweiten Hauptanschluss (7) nach oben in einem Lötofen verlötet wird.

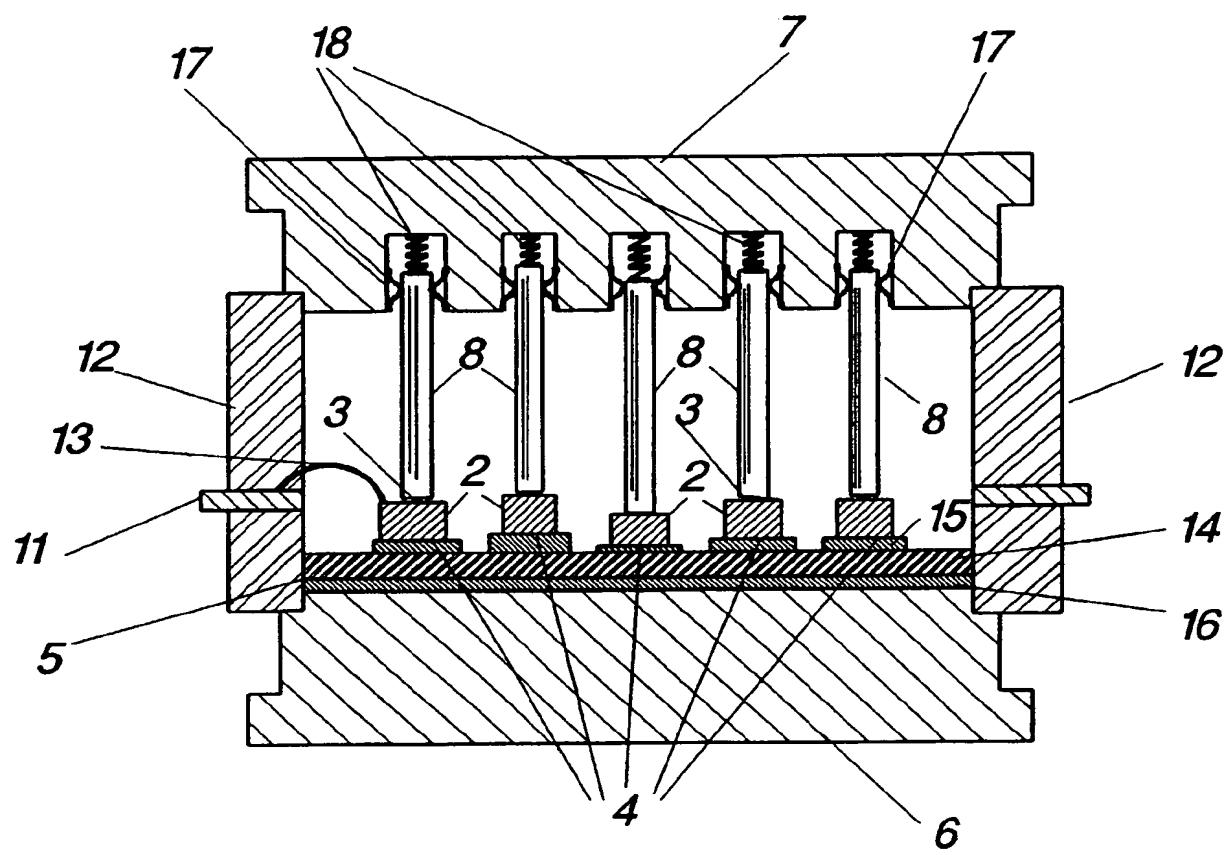
45

50

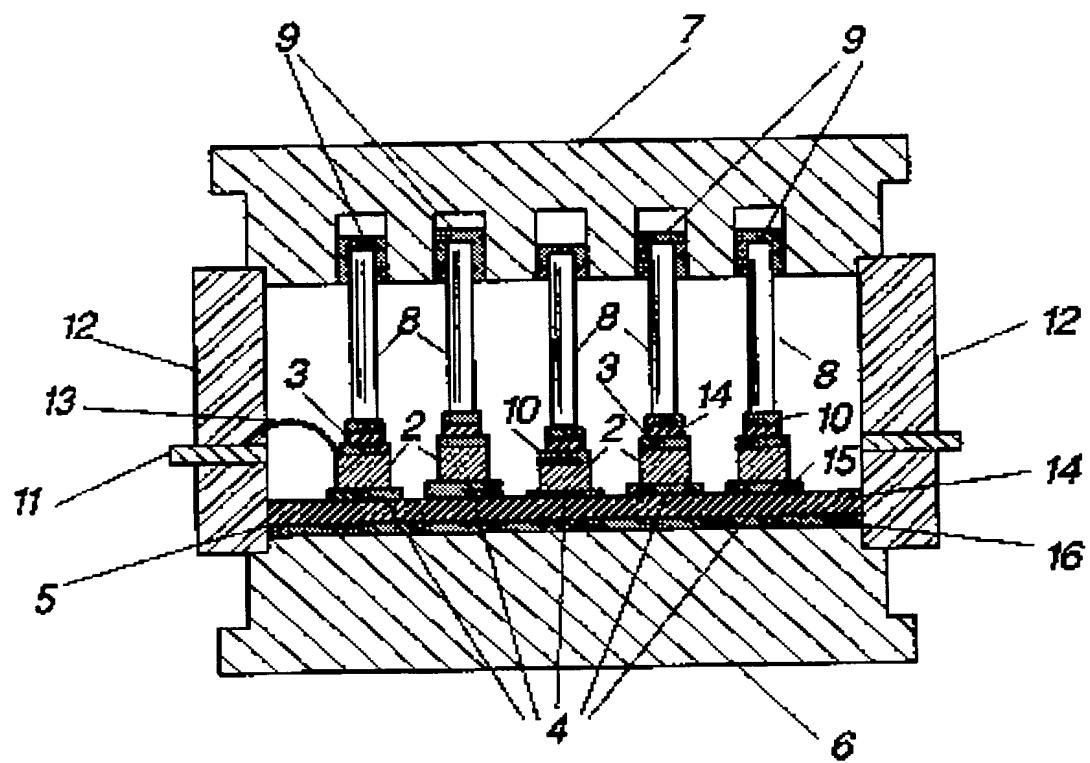
55



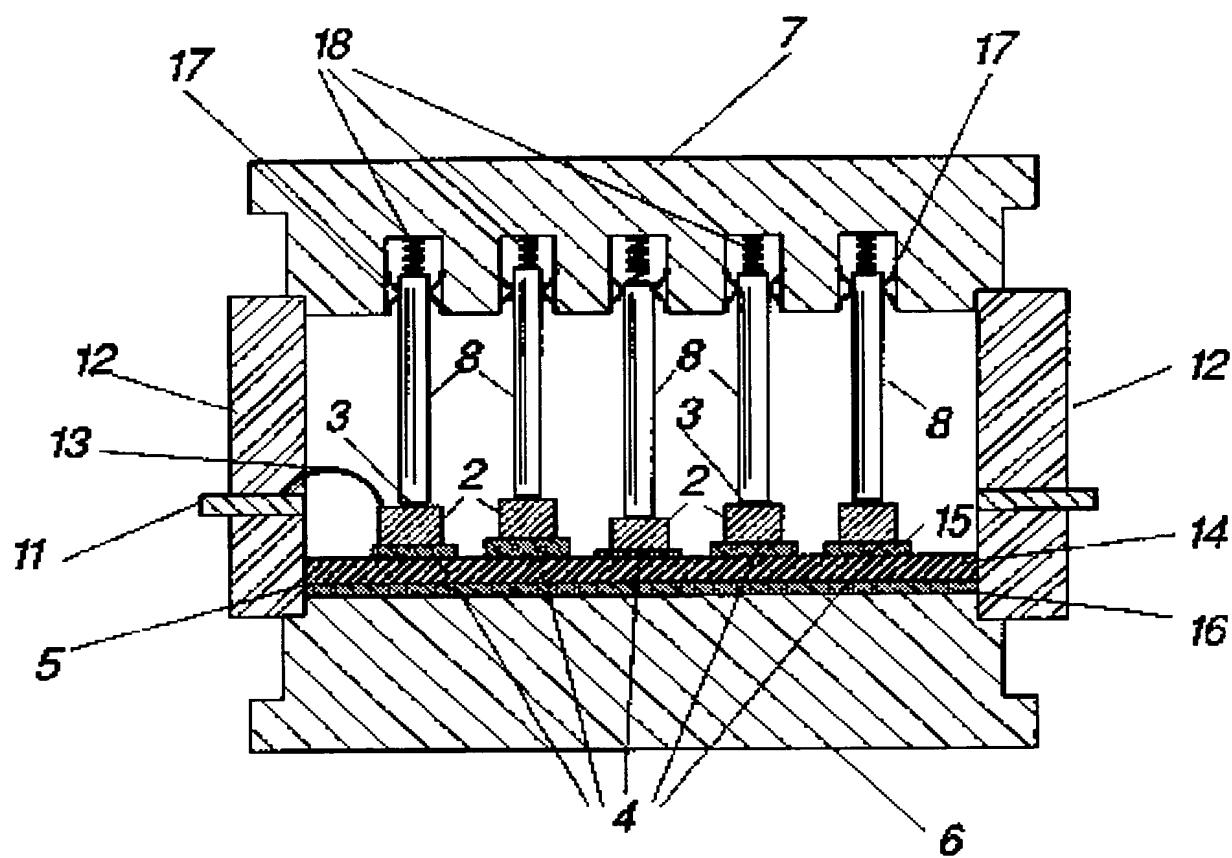
*Fig. 1*



*Fig.2*



*Fig. 1*



*Fig.2*

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11)



EP 0 762 496 A3

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:  
06.05.1999 Patentblatt 1999/18

(51) Int Cl. 6: H01L 23/49, H01L 23/48,  
H01L 25/07

(43) Veröffentlichungstag A2:  
12.03.1997 Patentblatt 1997/11

(21) Anmeldenummer: 96810501.5

(22) Anmeldetag: 26.07.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB IT

(30) Priorität: 17.08.1995 DE 19530264

(71) Anmelder: ABB RESEARCH LTD.  
8050 Zürich (CH)

(72) Erfinder:  
• Faller, Kurt  
5200 Brugg (CH)  
• Frey, Toni, Dr.  
La Jolla, CA 92037 (US)

• Keser, Helmut  
5408 Ennetbaden (CH)  
• Steinruck, Ferdinand  
6295 Mosen (CH)  
• Zehringer, Raymond, Dr.  
5444 Künten (CH)

(74) Vertreter: Weibel, Beat et al  
c/o Asea Brown Boveri AG,  
Intellectual Property Department (TEI),  
Bldg. 699/1st Floor,  
P.O. Box  
5401 Baden (CH)

### (54) Leistungshalbleitermodul

(57) Es wird ein Leistungshalbleitermodul angegeben, bei welchem mindestens ein Halbleiterchip (2), welcher auf einer Grundplatte (5) angebracht ist von je einem Kontaktstempel (8) kontaktiert wird. Die Lage der Kontaktstempel ist entsprechend einem Abstand von

den Halbleiterchips zu einem die Kontaktstempel aufnehmenden Hauptanschluss (7) individuell einstellbar. Die Kontaktstempel werden entweder mittels einer Feder mit Druck beaufschlagt oder mittels einer Lotschicht fixiert.

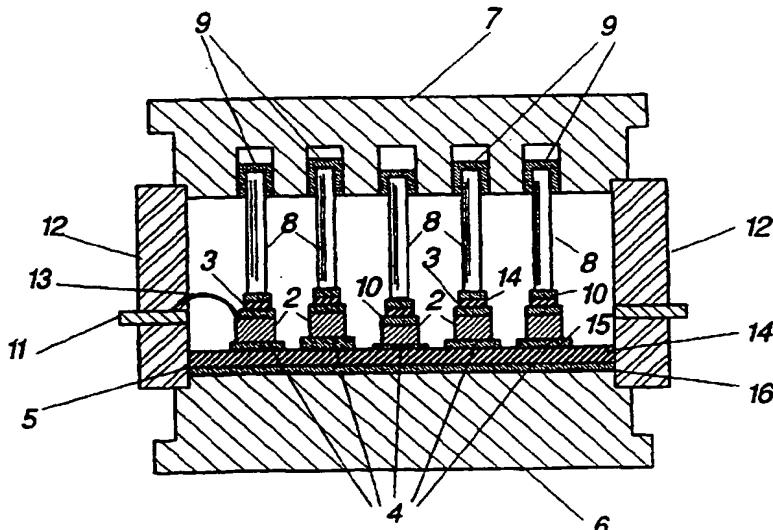


Fig.1

Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 96 81 0501

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betritt Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
Y	EP 0 158 749 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) 23. Oktober 1985 * Seite 4, Zeile 18 – Seite 6, Zeile 10; Abbildung 5 *	1-3,5	H01L23/49 H01L23/48 H01L25/07
Y,D	US 5 221 851 A (STOCKMEIER THOMAS ET AL) 22. Juni 1993 * Spalte 3, Zeile 60 – Spalte 5, Zeile 58; Abbildungen 1,5 *	1-3,5	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 133 (E-0902), 13. März 1990 & JP 02 001959 A (NEC CORP), 8. Januar 1990 * Zusammenfassung *	1-3,5	
A	"BIMETAL VLSI CHIP INTERCONNECTIONS" IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Bd. 29, Nr. 11, April 1987, Seite 5021/5022 XP002040446 Entire document	4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
A	US 5 098 305 A (JOHNSON DAVID J ET AL) 24. März 1992 Abstract * Abbildungen 4,5 *	3,4	H01L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	5. März 1999	Odgers, M	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			